

Gemini 1

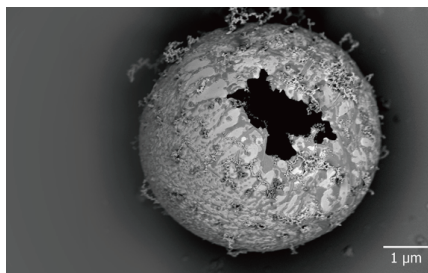
キャンペーン
2026年9月末
受注分まで

究極のイメージングと分析で未知の領域へ

多様な試料のサブナノメートルイメージングと
高度な分析を可能にするFE-SEM

ZEISS GeminiSEM Family

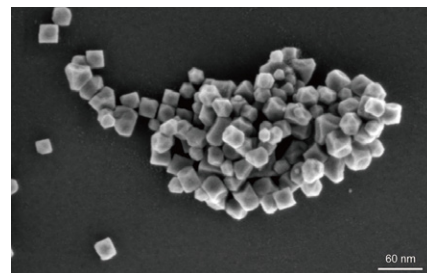
ZEISS GeminiSEM では、サブナノメートルの分解能でのイメージングを、様々な試料でストレス無く実現できます。ZEISS の最先端 FE-SEM（電界放出型走査電子顕微鏡）では、電子光学系のイノベーションと新しいチャンバー設計により、画質、操作性、柔軟性が向上しました。これにより、イマージョンレンズを使用せずに 1 kV 以下でサブナノメートル画像を取得できます。ZEISS GeminiSEM ファミリーの 3 種類の装置から、皆様の試料・アプリケーション・目的に応じた最適なソリューションをご提案します。



GeminiSEM 360 で取得したセリウム鉄粒子画像、Inlens EsB 像



硬質断面の EBSD 分析, GeminiSEM 460
20 kV, 5 nA, 20 分で 185,000 ポイント取得



磁性 FeMn ナノ粒子、辺長が約 25 nm の立方体
GeminiSEM 560, 1 kV, Inlens SE 像

ZEISS GeminiSEM 360

対応できる試料の多様性は 最高クラス

高感度表面イメージングにより、低加速電圧または高プローブ電流で情報を収集することができます。Inlens 検出、NanoVP など様々な条件でのイメージングに加え、コンテキストに基づいた画像統合管理やAIによるセグメンテーションのメリットを体感できます。

ZEISS GeminiSEM 460

高分解能と高電流の両方に対応

低電流・低電圧の作業から、高電流・高電圧の作業にシームレスに切り替えることができます。また、加熱・引張実験用の in situ ソリューションを追加することも可能です。同一平面上のEDS/EBSD設定を活用することで、EDSデータの影のないマッピングや1秒あたり4,000パターンものEBSDマップの迅速な収集もできます。

ZEISS GeminiSEM 560

表面イメージングの新たな基準

試料バイアスやモノクロメーションを必要としない、1 kV 以下かつ 1 nm 以下の分解能での磁場フリーイメージング、新たな電子光学エンジン Smart Autopilot を搭載した Gemini 3、データ取得条件のスイートスポットを見つけるなど、表面イメージングの新たな基準となる様々な機能が搭載されています。

ZEISS GeminiSEM 360

GeminiSEM 360 ショットキー電界放出型走査電子顕微鏡
インレンズ二次電子検出器、インレンズ EsB(反射電子)検出器、ET 検出器、
カラー CCD チャンバースコープ（仕様の詳細は弊社担当者にお問い合わせください。）

キャンペーン価格(税抜) **55,000,000 円～**

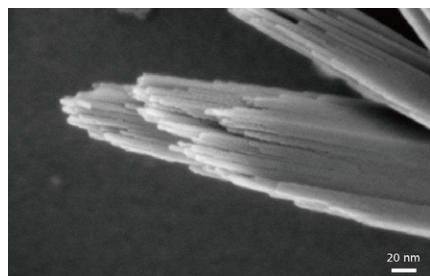


Seeing beyond

Gemini 1

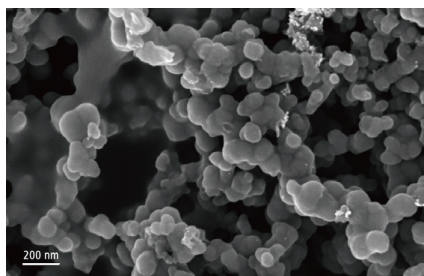
低加速電圧において高コントラストを実現！ さまざまなサンプルに対応可能 ZEISS GeminiSEM 360 / 460 / 560

ナノマテリアル



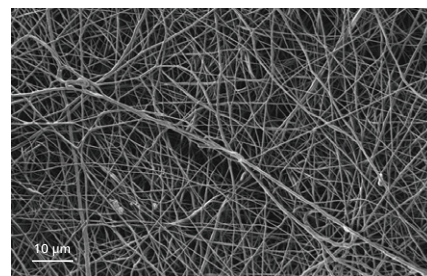
ナノメートル間隔で並んだ FeO(OH) 結晶。加速電圧：1 kV, 試料ご提供：L. Maniquet, INP Grenoble, France.

電池・エネルギー材料



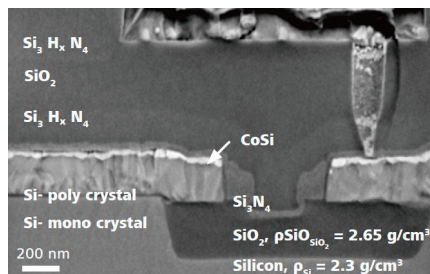
コーティングされていない電解質燃料電池材料。凝集したカーボンナノ粒子と直径 10 nm 未満のプラチナナノ粒子を含むマイクロボラス層

ポリマー・バイオ材料



組織工学でゼラチンナノファイバーを用いて作製した細胞培養用足場。試料ご提供：Fraunhofer IMWS, DE

エレクトロニクス



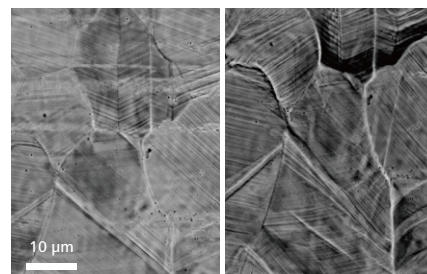
EsB 検出器 (エネルギー選択 BSE 検出器) によって実現される材料コントラストは、電子デバイス材料の僅かな組成差を判別できます。

半導体素子解析



14 nm SRAM の EBAC (電子ビーム吸収電流法) 解析。InLens 像 (8 kV) と EBAC データ (赤) の重ね合わせ。

in situ 試験



ステンレス鋼の in situ (その場) 引張試験中の AsB 像。引張によるスリップバンドの形成を、荷重前 (左) および後 (右) の画像で捉えています。

ZEISS GeminiSEM 360

分解能*	@ 30 kV (STEM)	0.6 nm
	@ 15 kV /DCV**	0.7 nm / 0.5 nm
	@ 1 kV /DCV**	1.2 nm / 1.0 nm
加速電圧		0.02 – 30 kV
倍 率		8x – 2,000,000x
プローブ電流		3 pA – 20 nA (100 nA: オプション)
VPモード		10 – 500 Pa (オプション)

* 最適作動距離：設置時の検収試験において、1 kV および 15 kV で分解能の実証を実施 (高真空、DCV なし)

** デコンボリューション使用時の分解能



GeminiSEM ファミリーの
各製品や各種オプションの
詳細情報はこちら！



カールツァイス株式会社
ZEISS Research Microscopy Solutions
info.microscopy.jp@zeiss.com



Seeing beyond